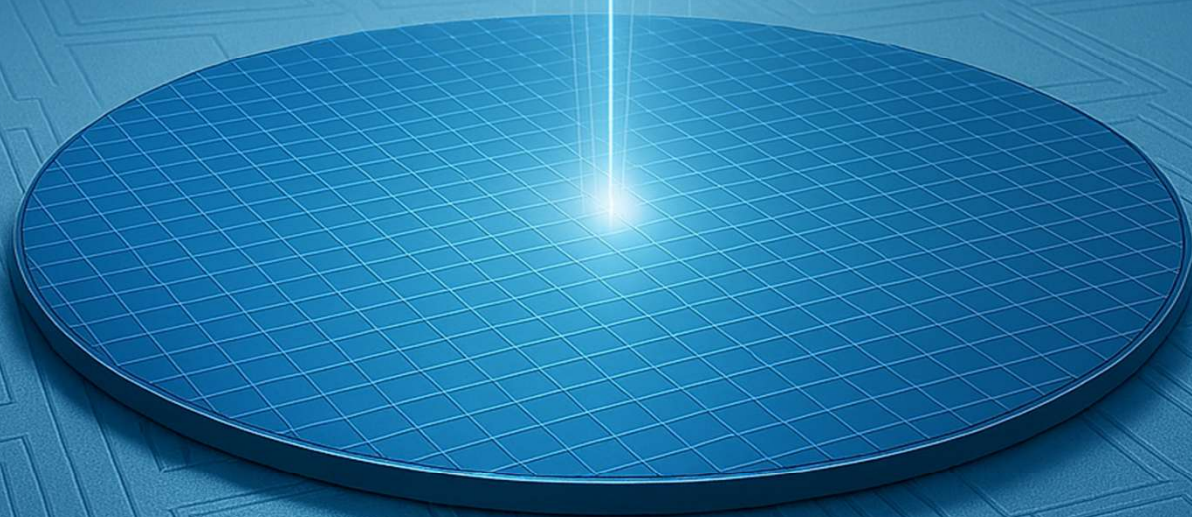


その一撃。



SiCの未来を変える。



SF-KHII®

イオンの力で通電時の欠陥拡張を抑制



住重アテックス株式会社

SF-KHII®

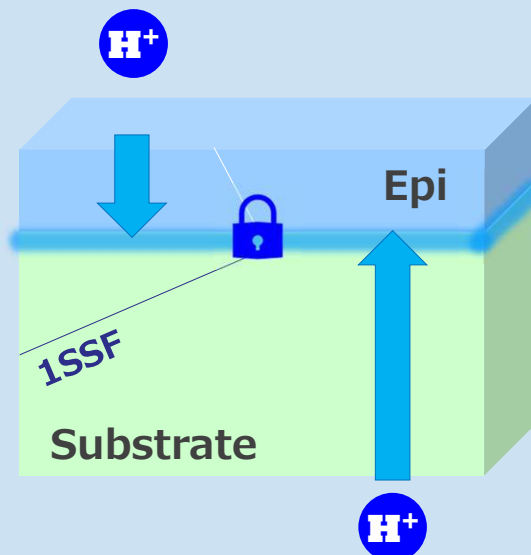
Stacking Fault Knocking-down by High-energy Ion Implantation

SiC積層欠陥拡張の問題を解決！

・イオン注入により
積層欠陥拡張の
抑制が可能！

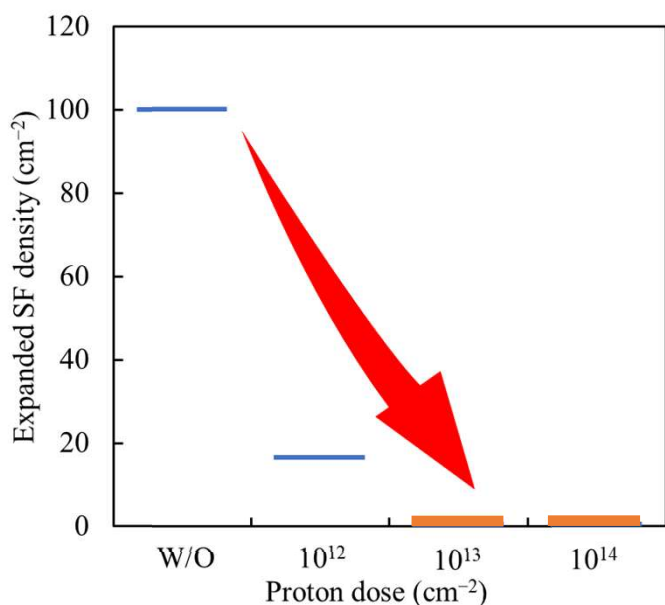
・高エネルギーだから
裏面注入も可能！

Low energy !



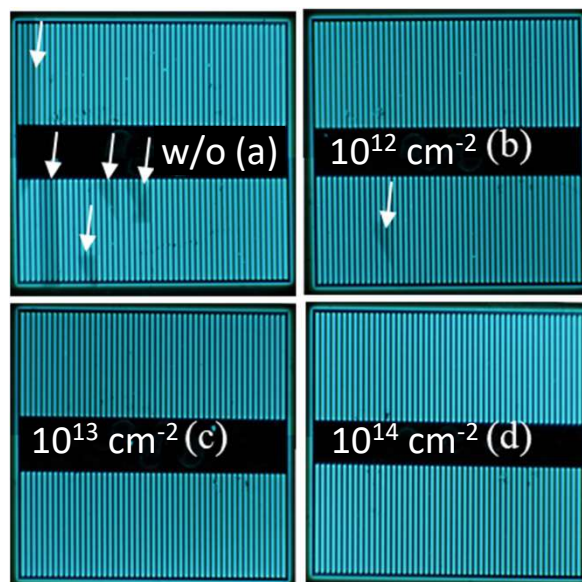
High energy !

積層欠陥の密度比較



10¹²cm⁻²程度の注入量でも抑制効果が得られる事が分かり、10¹³cm⁻²以上では欠陥の拡張は確認されませんでした。

電流ストレス後のEL像



イオン注入量を増加させることで、暗部（拡張された積層欠陥）の発生を防ぐことができます。



住重アテックス株式会社